

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la
Propriété Intellectuelle
Bureau international



(10) Numéro de publication internationale
WO 2019/186268 A1

(43) Date de la publication internationale
03 octobre 2019 (03.10.2019)

WIPO | PCT

(51) Classification internationale des brevets :

C30B 23/02 (2006.01) C30B 29/42 (2006.01)
C30B 25/18 (2006.01) H01L 21/762 (2006.01)

(72) Inventeur : GHYSELEN, Bruno ; 58 rue Georges Maeder,
38170 Seyssinet (FR).

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(21) Numéro de la demande internationale :

PCT/IB2019/000207

(22) Date de dépôt international :

26 mars 2019 (26.03.2019)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :

1800252 28 mars 2018 (28.03.2018) FR

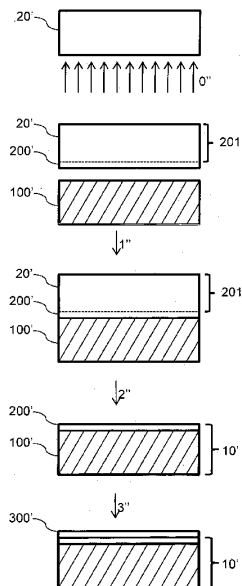
(71) Déposant : SOITEC [FR/FR] ; Chemin des Franques, Parc
Technologique des Fontaines, 38190 Bernin (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), européen (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES,

(54) Title: METHOD FOR MANUFACTURING A MONOCRYSTALLINE LAYER OF GAAS MATERIAL AND SUBSTRATE FOR EPITAXIAL GROWTH OF A MONOCRYSTALLINE LAYER OF GAAS MATERIAL

(54) Titre : PROCÉDÉ DE FABRICATION D'UNE COUCHE MONOCRISTALLINE DE MATÉRIAU GAAS ET SUBSTRAT POUR CROISSANCE PAR ÉPITAXIE D'UNE COUCHE MONOCRISTALLINE DE MATÉRIAU GAAS

Figure 2



(57) Abstract: The invention relates to a method for manufacturing a monocrystalline layer of GaAs material comprising the transfer of a monocrystalline seed of SrTiO₃ material onto a support substrate of silicon material followed by epitaxial growth of a monocrystalline layer of GaAs material.

(57) Abrégé : Procédé de fabrication d'une couche monocristalline de matériau GaAs comprenant le transfert d'une couche germe monocristalline de matériau SrTiO₃ sur un substrat support de matériau silicium suivi d'une croissance par épitaxie d'une couche monocristalline de matériau GaAs.

[Suite sur la page suivante]

FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK,
MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI
(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

Déclarations en vertu de la règle 4.17 :

- *relative au droit du déposant de demander et d'obtenir un brevet (règle 4.17(ii))*
- *relative au droit du déposant de revendiquer la priorité de la demande antérieure (règle 4.17(iii))*
- *relative à la qualité d'inventeur (règle 4.17(iv))*

Publiée:

- *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*